

上海伯东代理美国 KRI 霍尔离子源 Gridless eH 系列

产品名称	上海伯东代理美国 KRI 霍尔离子源 Gridless eH 系列
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:Gridless eH 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

产品详情

美国 KRI 霍尔离子源 Gridless eH 系列美国 KRI 霍尔离子源 eH 系列紧凑设计, 高电流低能量宽束型离子源, 提供原子等级的细微加工能力, 霍尔离子源 eH 可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种型号满足科研及工业, 半导体应用. 霍尔离子源高电流提高镀膜沉积速率, 低能量减少离子轰击损伤表面, 宽束设计提高吞吐量和覆盖沉积区. 整体易操作, 易维护. 霍尔离子源 eH 提供一套完整的方案包含离子源, 电子中和器, 电源供应器, 流量控制器 MFC 等等可以直接整合在各类真空设备中, 例如镀膜机, load lock, 溅射系统, 卷绕镀膜机等. 美国 KRI 霍尔离子源 eH 特性无栅极高电流低能量发散光束 >45°可快速更换阳极模块可选 Cathode / Neutralize 中和器美国 KRI 霍尔离子源 eH 主要应用辅助镀膜 IBAD 溅镀 & 蒸镀 PC 表面改性、激活 SM 沉积 (DD) 离子蚀刻 LIBE 光学镀膜 Biased target ion beam sputter deposition (BTIBSD) Ion Beam Modification of Material Properties (IBM)

例如1. 离子辅助镀膜及电子枪蒸镀2. 线上式磁控溅射及蒸镀设备预清洗3. 表面处理4. 表面硬化层镀膜5. 磁控溅射辅助镀膜7. 偏压离子束磁控溅射镀膜

霍尔离子源 eH 系列在售型号:

型号	eH400	eH1000	eH2000	eH3000	eHL
中和器	F or HC	F or HC	F or HC	F or HC	F
阳极电压	50-300 V	50-300 V	50-300 V	50-250 V	50-300 V
离子束流	5A	10A	10A	20A	根据
散射角度	>45°	>45°	>45°	>45°	>45°
气体流量	2-25 sccm	2-50 sccm	2-75 sccm	5-100 sccm	根据
本体高度	3.0 “	4.0 “	4.0 “	6.0 “	根据
直径	3.7 “	5.7 “	5.7 “	9.7 “	根据

水冷

可选

可选

是

可选

根据

F = Filament; HC = Hollow Cathode; xO2 = Optimized for O2 current
1978 年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司, 研发生产考夫曼离子源, 霍尔离子源和射频离子源。
美国考夫曼离子源历经 40 年改良及发展已取得多项专利。离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜 IBSD 领域,
上海伯东是美国考夫曼离子源中国总代理。若您需要进一步的了解 [KRI 霍尔离子源](#),
请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生